

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 4 区分

【発行日】平成24年4月12日 (2012.4.12)

【公開番号】特開2010-272156(P2010-272156A)

【公開日】平成22年12月2日 (2010.12.2)

【年通号数】公開・登録公報2010-048

【出願番号】特願2009-121733(P2009-121733)

【国際特許分類】

G 1 1 C 16/02 (2006.01)

G 1 1 C 16/06 (2006.01)

【F I】

G 1 1 C 17/00 6 0 1 P

G 1 1 C 17/00 6 0 1 Q

G 1 1 C 17/00 6 3 2 A

G 1 1 C 17/00 6 0 1 D

G 1 1 C 17/00 6 3 2 D

G 1 1 C 17/00 6 3 2 Z

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月27日 (2012.2.27)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

電氣的に書換可能な不揮発性のメモリセルが複数配列された第 1 および第 2 のメモリアレイと、

各前記メモリセルのデータ書換に必要な書換電圧を生成する第 1 の電源回路と、

前記第 1 および第 2 のメモリアレイのデータ書換を指令する書換指令部と、

第 1 の書換可能信号が活性化状態の場合に、前記書換指令部の指令に従って前記第 1 の電源回路から前記第 1 のメモリアレイに前記書換電圧を供給する第 1 の電圧供給制御部と

、

第 2 の書換可能信号が活性化状態の場合に、前記書換指令部の指令に従って前記第 1 の電源回路から前記第 2 のメモリアレイに前記書換電圧を供給する第 2 の電圧供給制御部とを備える、半導体装置。